

公私場所名稱：\_\_\_\_\_

公私場所地址：\_\_\_\_\_

電 話：\_\_\_\_\_ 傳 真：\_\_\_\_\_

負 責 人 姓 名：\_\_\_\_\_

聯 絡 人 姓 名：\_\_\_\_\_ 聯絡人電話：\_\_\_\_\_

工廠登記證編號：

--	--	--	--	--	--	--	--

所屬製程編號：\_\_\_\_\_

申報月份：中華民國 \_\_\_\_年\_\_\_\_月 ~ \_\_\_\_年\_\_\_\_月

申報日期：中華民國 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 半導體製造業

### 揮發性有機物及無機酸

### 污染防制紀錄申報書

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

所屬年月份： 年 月 ~ 月；

所屬行業別：

一、揮發性有機物及三氯乙烯(TCE)輸入紀錄	產品名稱 平均產量(單位： )	1	2	3	4	平均每日工作 時數(小時)	
	年 月						
	年 月						
	年 月						
	合計						
	<b>1. 含 VOC 的物質使用量 ( □公升/月 □公斤/月 )</b>						
	時間 種類	年 月	年 月	年 月	年 月	合 計	
	光阻劑						
	去光阻劑						
	顯影液						
	IPA						
	丙酮						
	合計						
	<b>2. 含三氯乙烯(TCE)的物質使用量( □公升/月 □公斤/月 )</b>						
	三氯乙烯						
	合計						
						頁次	

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

二、無機酸輸入紀錄	<b>1.含硫酸(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)物質使用量( □公升/月 □公斤/月 )</b>				
	時間	年	月	年	月
	種類				合 計
	合計				
	<b>2.含鹽酸(HCl)物質使用量( □公升/月 □公斤/月 )</b>				
合計					
<b>3.含硝酸(HNO<sub>3</sub>)物質使用量( □公升/月 □公斤/月 )</b>					
合計					
				頁次	

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

二、無機酸輸入紀錄	<b>4.含磷酸(H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>)物質使用( <input type="checkbox"/>公升/月 <input type="checkbox"/>公斤/月 )</b>				
	時間	年	月	年	月
	種類				合 計
	合計				
	<b>5.含氫氟酸(HF)物質使用量( <input type="checkbox"/>公升/月 <input type="checkbox"/>公斤/月 )</b>				
合計					
<b>6.混合酸使用量( <input type="checkbox"/>公升/月 <input type="checkbox"/>公斤/月 )</b>					
合計					
				頁次	







所屬月份： 年 月

防制設備編號								排放口編號			
--------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

四、空氣污染防制設備操作紀錄資料	防制設備名稱											
	設計處理風量		Nm <sup>3</sup> /min		燃燒溫度下限		℃		濃縮脫附溫度下限		℃	
	紀錄項目日期	廢氣處理前濃度(ppm)	廢氣處理後濃度(ppm)	燃燒溫度(℃)	濃縮脫附溫度(℃)	去除率(%)	廢氣排放量(Nm <sup>3</sup> /min)	VOC 排放量(kg/hr)				
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	26											
	27											
28												
29												
30												
31												
備註 1：請併附固定污染源設置操作許可表 AP-M 之製程設備、污染防制設備及排放口之方塊流程圖。 2：未設置濃度監測器者，免填廢氣處理前濃度、廢氣處理後濃度、去除率或 VOC 排放量。 3：廢氣處理前濃度、廢氣處理後濃度及廢氣排放量應記錄比測修正之日平均值。請以附頁註明去除率、廢氣排放量及 VOC 排放量之計算方式。												





所屬月份： 年 月

防制設備編號

排放口編號

四、空氣污染防制設備操作紀錄資料	防制設備名稱						
	設計處理風量	Nm <sup>3</sup> /min	進口溫度上限	°C	出口相對溼度下限	%	
	紀錄項目日期	廢氣處理前濃度(ppm)	廢氣處理後濃度(ppm)	進口溫度(°C)	出口相對溼度(%)	去除率(%)	VOC 排放量(kg/hr)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

頁次

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

所屬月份： 年 月～ 月

熱焚化適用

		防制設備編號				排放口編號			
四、空氣污染防制設備操作紀錄資料	防制設備名稱	燃燒溫度下限		°C		設計處理風量		Nm <sup>3</sup> /min	
	紀錄月份	月		月		月			
	紀錄項目日期	燃燒溫度(°C)	廢氣排放量(Nm <sup>3</sup> /min)	燃燒溫度(°C)	廢氣排放量(Nm <sup>3</sup> /min)	燃燒溫度(°C)	廢氣排放量(Nm <sup>3</sup> /min)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

備註 1：請併附固定污染源設置操作許可表 AP-M 之製程設備、污染防制設備及排放口之方塊流程圖。  
2：廢氣排放量記錄比測修正之結果。

頁次

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

所屬月份： 年 月

觸媒焚化適用

		防制設備編號				排放口編號				
四、空氣污染防制設備操作紀錄資料	防制設備名稱		設計處理風量				Nm <sup>3</sup> /min			
	使用觸媒種類		使用觸媒總重量(公噸)							
	紀錄項目日期	觸媒床進口溫度(°C)	觸媒床出口溫度(°C)	是否更換觸媒	是否再生觸媒	廢氣排放量 Nm <sup>3</sup> /min				
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
備註 1：請併附固定污染源設置操作許可表 AP-M 之製程設備、污染防制設備及排放口之方塊流程圖。 2：廢氣排放量記錄比測修正之結果。										

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

所屬月份： 年 月

其他污染防制設備適用

		防制設備編號			設計處理風量			排放口編號		
四、 空氣 污染 防制 設備 操作 紀錄 資料	防制設備名稱				Nm <sup>3</sup> /min					
	操作參數上下限	<sup>1</sup> 上(下)限		<sup>2</sup> 上(下)限		<sup>3</sup> 上(下)限				
	紀錄項目 日期	1	2	3	廢氣處理前 濃度(ppm)	廢氣處理後 濃度(ppm)	去除率 (%)	廢氣排放量 (Nm <sup>3</sup> /min)	VOC 排放量 (kg/hr)	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

備註 1：請併附固定污染源設置操作許可表 AP-M 之製程設備、污染防制設備及排放口之方塊流程圖。  
 2：未設置濃度監測器者，免填廢氣處理前濃度、廢氣處理後濃度、去除率或 VOC 排放量。  
 3：廢氣處理前濃度、廢氣處理後濃度及廢氣排放量應記錄比測修正之日平均值。請以附頁註明去除率、廢氣排放量及 VOC 排放量之計算方式。

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

				排放口編號					
五、直接排放之排放管道檢測資料紀錄表	檢測日期	排氣風量(Nm <sup>3</sup> /min)	溼基(Nm <sup>3</sup> /min)	乾基(Nm <sup>3</sup> /min)	含水率%				
	年 月 日								
	檢測項目 時間	揮發性有機物 平均濃度(ppm)	揮發性有機物 平均排放量(kg/hr)	三氯乙烯 平均濃度(ppm)	三氯乙烯 平均排放量(kg/hr)				
	第 1 小時								
	第 2 小時								
	第 3 小時								
	第 4 小時								
	第 5 小時								
	第 6 小時								
	第 7 小時								
	第 8 小時								
	總平均值								
	檢測期間製程條件								
製程編號	1	2	3	4					
產品名稱									
平均產量									
製程編號	5	6	7	8					
產品名稱									
平均產量									
備註 1：已設置濃度監測器之檢測口免填									
								頁次	

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

		防制設備編號				排放口編號			
六、 污 染 防 制 設 備 處 理 前 後 之 排 放 管 道 檢 測 資 料 紀 錄 表	檢測日期	排氣風量(Nm <sup>3</sup> /min)		溼基(Nm <sup>3</sup> /min)		乾基(Nm <sup>3</sup> /min)		含水率%	
	年 月 日								
	檢測項目 時間	揮發性有機物平均濃度(ppm)		揮發性有機物 平均排放量(kg/hr)	三氯乙烯平均濃度(ppm)		三氯乙烯平均 排放量(kg/hr)		
		防制設備前	防制設備後		防制設備前	防制設備後			
	第 1 小時								
	第 2 小時								
	第 3 小時								
	第 4 小時								
	第 5 小時								
	第 6 小時								
	第 7 小時								
	第 8 小時								
	總平均值								
	防制設備去除 率或排放量	揮發性有機物去除率： %		排放量： (kg/hr)	三氯乙烯去除率： %		排放量： (kg/hr)		
	檢測期間製程條件								
製程編號	1	2	3	4					
產品名稱									
平均產量									
製程編號	5	6	7	8					
產品名稱									
平均產量									
檢測期間處理設備條件									
防制設備名稱									
操作條件	1	2	3	4					
數據及單位									
備註 1：已設置濃度監測器之檢測口免填 備註 2：計算防制設備去除率及排放總量，採取所測得濃度之總平均值。 備註 3：處理設備操作條件：為轉輪濃縮焚化及熱焚化爐者，記錄燃燒溫度；為觸媒焚化者，記錄觸媒種類、觸媒床更換日期及觸媒床進、出口氣體溫度；為洗滌者，記錄各洗滌槽洗滌循環水量、廢水排放量；。以其他污染防制設備處理者，記錄主要操作參數。									
						頁次			

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

七、污染防制設備處理前後之濃度偵測器比測資料紀錄表	防制設備編號		排放口編號		
	濃度監測器廠牌	比測日期		年 月 日	
	揮發性有機物平均濃度(ppm)				
	比測位置	防制設備前		防制設備後	
	時間	標準方法	濃度監測器	標準方法	濃度監測器
	第 1 小時				
	第 2 小時				
	總平均值				
	修正係數				
	防制設備編號		排放口編號		
濃度監測器廠牌	比測日期		年 月 日		
揮發性有機物平均濃度(ppm)					
比測位置	防制設備前		防制設備後		
時間	標準方法	濃度監測器	標準方法	濃度監測器	
第 1 小時					
第 2 小時					
總平均值					
修正係數					
防制設備編號		排放口編號			
濃度監測器廠牌	比測日期		年 月 日		
揮發性有機物平均濃度(ppm)					
比測位置	防制設備前		防制設備後		
時間	標準方法	濃度監測器	標準方法	濃度監測器	
第 1 小時					
第 2 小時					
總平均值					
修正係數					
備註 1：未設置濃度監測器之檢測口免填					
備註 2：修正係數係指標準方法測得之平均濃度比上濃度監測器測得者。					

半導體製造業揮發性有機物及無機酸污染防制紀錄申報書

七、污染防制設備處理前	防制設備編號										排放口編號				
	流量計廠牌										比測日期		年	月	日
	流量 (乾基, Nm <sup>3</sup> /min)														
	比測位置		防制設備前						防制設備後						
	時間	標準方法			流量計			標準方法			流量計				
	第 1 小時														
	第 2 小時														
	總平均值														
	修正係數														
	之流量計比測資料紀錄表	防制設備編號										排放口編號			
流量計廠牌										比測日期		年	月	日	
流量 (乾基, Nm <sup>3</sup> /min)															
比測位置		防制設備前						防制設備後							
時間		標準方法			流量計			標準方法			流量計				
第 1 小時															
第 2 小時															
總平均值															
修正係數															
之流量計比測資料紀錄表		防制設備編號										排放口編號			
	流量計廠牌										比測日期		年	月	日
	流量 (乾基, Nm <sup>3</sup> /min)														
	比測位置		防制設備前						防制設備後						
	時間	標準方法			流量計			標準方法			流量計				
	第 1 小時														
	第 2 小時														
	總平均值														
	修正係數														
	備註 1：未設置流量計之檢測口免填														
備註 2：修正係數係指標準方法測得之平均濃度比上流量計測得者。															